



三洋半導体  
ニュース

No.1399

8043

# 2SC3484

シリコン NPN 三重拡散アレーナ型トランジスタ

高精細度CRTディスプレイ水平偏向出力用

特長 ・高耐圧, 高信頼性である.

- ・スイッチングスピードが速い:  $t_f = 0.3 \mu s \text{ max.}$
- ・一点止め樹脂モールドパッケージで 取り付け作業性が良い.

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a = 25^\circ C$

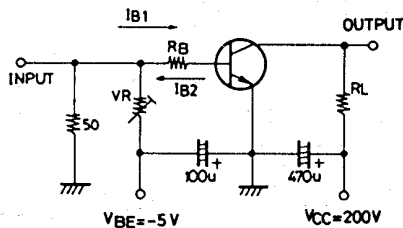
			unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	800	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	7	V
コレクタ電流	$I_C$	3.5	A
ピークコレクタ電流	$i_{cp}$	10	A
コレクタ損失	$P_C$	$T_c = 25^\circ C$	80 W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存周囲温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ C$

電気的特性 Electircal Characteristics/ $T_a = 25^\circ C$

			min	typ	max	unit
コレクタしや断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = 800V, I_E = 0$			10	$\mu A$
エミッタしや断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$			1	mA
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 0.5A$	8			
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = 10V, I_C = 0.5A$		3		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2.5A, I_B = 0.8A$			8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 2.5A, I_B = 0.8A$			1.5	V
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C = 5mA, I_E = 0$	1500			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = 5mA, R_{BE} = \infty$	800			V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = 5mA, I_C = 0$	7			V
蓄積時間	$t_{stg}$	$I_C = 3A, I_{B1} = 0.8A,$ $I_{B2} = -1.6A,$ $R_L = 66.7\Omega$			3.0	$\mu s$
下降時間	$t_f$				0.3	$\mu s$

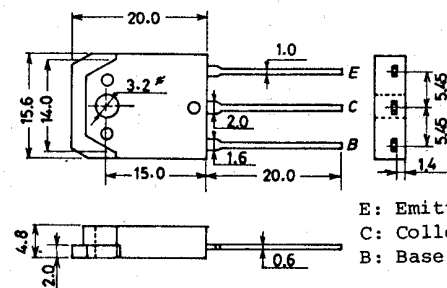
スイッチングタイム測定回路

$PW = 20\mu s, \text{Duty} \leq 1\%$



外形図 2022

(unit: mm)



E: Emitter  
C: Collector  
B: Base

\* これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県大泉町坂田180

東京三洋電機(株)半導体事業部

TEL 0276-63-2111 (大代表)